FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a=25°C)					電気的特性 (T_a=25°C)											外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1163																								
〃 1164	東芝	RF. SW	Si.E	−35	−5	−100	200	125	−0.1	−35	200	−12	−2	−12	10	t_{on}<60nS, t_f<140nS t_{stg}<500nS				400 *	2.5	40	138	
〃 1165																								
〃 1166	日電	PA	Si.E	−160	−5	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−150	150	−5	−2A	−5	1A					60 *	320	10	340	
〃 1167																								
〃 1168																								
〃 1169	サンケン	PA	Si.EP	−200	−6	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−200	80	−4	−5A	−12	500					20 *	400	7	256	
〃 1170	〃	〃	〃	−200	−6	−17A	200W (Tc=25°C)	150	−100	−200	70	−4	−8A	−12	1A					20 *	500	7	256	
〃 1171																								
〃 1172																								
〃 1173	日電	AF	Si.E	−140	−5	−50	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−140	200	−10	−10	−10	10					80 *	2.5		336	2SC2780とコンプリ
〃 1174	〃	RF. LN	〃	−60		−50	300	125	−0.1	−50	400	−6	−1	−6	1	NF= 1 dB (6 V, 1 mA, 1 kHz)				90 *	2	$C_{c\,rbb'}$ 100pS	42	
〃 1175	〃	AF	〃	−60	−5	−100	300	125	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	10	NF= 6 dB (−6 V, −0.3mA, f=100Hz)				180 *	4.5		42	2SC2785とコンプリ
〃 1176																								
〃 1177																								
〃 1178																								
〃 1179	三洋	AF	Si.EP	−55	−5	−150	200	125	−0.1	−35	100~560	−6	−1	−6	1					180 *	7		176	
〃 1180	富士通	SW	〃	−150	−5	−15A	80W (Tc=25°C)	175	−50	−150	60	−5	−1.5A			t_r<0.5μS, t_f<0.5μS t_{stg}<0.5μS							102	
〃 1181																								
〃 1182																								
〃 1183																								
〃 1184	東芝	RF	Si.E	−120	−5	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−0.1	−120	150	−5	−100	−5	100					120 *	30	3 *	342	
〃 1185	松下	PA	Si.EP	−50	−5	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	60~320	−5	−1A	5	−500					100 *	250		152	
〃 1186	サンケン	〃	〃	−150	−5	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−3A	−12	1A					60 *	110	20	324	
〃 1187	〃	〃	〃	−150	−5	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−3A	−12	1A					60 *	110	20	256	
〃 1188	日立	RF. AF	Si.E	−90	−5	−100	400	125	−0.1	−70	450	−12	−2	−6	10					130 *	3.2	30	138	
〃 1189	〃	〃	〃	−120	−5	−100	400	125	−0.1	−70	400	−12	−2	−6	10					130 *	3.2	30	138	
〃 1190	〃	RF. LN	〃	−90	−5	−100	400	125	−0.1	−70	450	−12	−2	−6	10	NF=0.15dB (6 V, 0.1mA, 1 kHz)				130 *	3.2	30	138	
〃 1191	〃	〃	〃	−120	−5	−100	400	125	−0.1	−70	400	−12	−2	−6	10	NF=0.15dB (6 V, 0.1mA, 1 kHz)				130 *	3.2	30	138	
〃 1192																								